

2SD889

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形

低周波増幅用

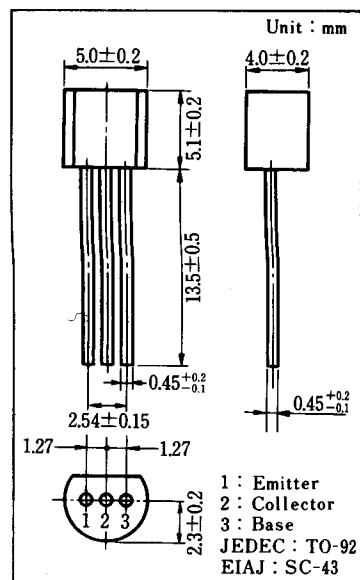
2SB774 とコンプリメンタリ

■ 特 長

- エミッタ・ベース電圧 V_{EBO} が高い。
- エミッタ・ベース間の保護用ダイオード、抵抗が省略できる。

■ 絶対最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	25	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	15	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	200	mA
コレクタ電流	I_C	100	mA
コレクタ損失	P_C	400	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=0$			1	μA
	I_{CEO}	$V_{CE}=20\text{ V}, I_B=0$			100	
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C=10\text{ }\mu\text{A}, I_E=0$	30			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=2\text{ mA}, I_B=0$	25			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=10\text{ }\mu\text{A}, I_C=0$	15			V
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=2\text{ mA}$	120		650	
	h_{FE2}	$V_{CE}=2\text{ V}, I_C=100\text{ mA}$	90			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{ mA}, I_B=10\text{ mA}$			0.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=-2\text{ mA}, f=200\text{ MHz}$		150		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=0, f=1\text{ MHz}$		3		pF

* h_{FE1} ランク分類

ランク	P	Q	R	S	T
h_{FE1}	120~200	160~260	210~340	290~460	400~650